

هدف ما در این فصل محاسبه میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی است. تجربه نشان داده که در اطراف سیم حامل جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. برای محاسبه میدان به دو روش خواهیم پرداخت:

- ۱- قانون بیوساوار (مربوط به روش مستقیم در محاسبه میدان الکتریکی).
- ۲- قانون آمپر (مربوط به قانون گاوس در محاسبه میدان الکتریکی).

قانون بیوساوار: هنگامی که از یک سیم، جریان می‌گذرد، برای محاسبه میدان اطراف سیم، ابتدا سیم را به عناصر کوچک dl در جهت جریان تقسیم کرده، فاصله آن dl تا نقطه مورد نظر (جایی که می‌خواهیم میدان مغناطیسی را در آن محاسبه کنیم) تعیین کرده

$\vec{r}$ (جهت از dl به نقطه مورد نظر) و در این صورت:



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left(\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right) \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

$d\vec{B}$ بر dl و $\vec{r}$ عمود است و جهت با قاعده دست راست. (مشت دست راست را در جهت جریان قرار داده، جهت بسته

شکل انگشتان، جهت میدان را نشان می‌دهد).

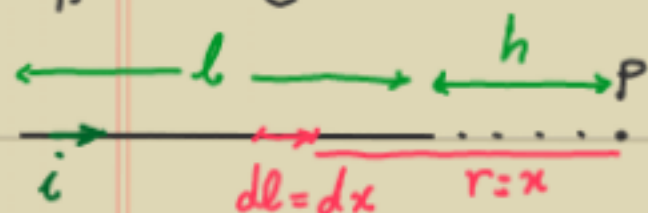
$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl r \sin\theta$$

رابطه فوق به قانون بیوساوار معروف است.

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{(dl \sin\theta)}{r^2}$$

با انتخاب یک دستگاه مختصات مناسب، در صورت نیاز dB را به مولفه‌های تجزیه کرده و روی طول سیم از آن اشتغال گیری می‌کنیم.

مثال ۱- از سیم مستقیم به طول l ، جریان i مطابق شکل می‌گذرد. میدان مغناطیسی را در نقطه ای واقع بر امتداد سیم، به فاصله h



از یک سر آن محاسبه کنید.

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{(dl \sin\theta)}{r^2} \xrightarrow{\theta=0} dB=0 \rightarrow B=0$$

نتیجه: سیم حامل جریان در نقاط واقع بر امتداد خود ($\theta=0$ یا $\theta=\pi$) میدان مغناطیسی ایجاد نمی‌کند.

✓ مثال ۲- برای سیم حامل جریان در مثال ۱، میدان مغناطیسی را در نقطه ای به فاصله عمودی h از یک سر سیم حساب کنید.



$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left(\frac{dl \sin \theta}{r^2} \right) = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left(\frac{dx h}{(x^2 + h^2)^{3/2}} \right)$$

جهت میدان در نقطه P درون سیم است و با جای کردن همان جهت dB تغییر

نمی‌کند. نیاز به تجزیه ندارد.

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 i h}{4\pi} \int_0^l \frac{dx}{(x^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i h}{4\pi} \left(\frac{x}{h^2 \sqrt{x^2 + h^2}} \right)_0^l$$

$$B_P = \frac{\mu_0 i l}{4\pi h \sqrt{l^2 + h^2}}$$

✓ مثال ۳- برای سیم حامل جریان مثال ۱، میدان مغناطیسی را روی عمود وسط سیم، به فاصله h از سیم حساب کنید.



مراحل کاملاً شبیه به مثال ۲ است، فقط محدوده انتگرال از $-\frac{l}{2}$ تا $\frac{l}{2}$

$\frac{l}{2}$ خواهد بود.

$$B_P = \int dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi h} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} \right)_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{\mu_0 i l}{4\pi h \sqrt{\frac{l^2}{4} + h^2}}$$

در وینو.

✓ مثال ۴- میدان مغناطیسی سیم مستقیم نامتناهی با جریان i را در نقطه ای به فاصله h از سیم حساب کنید.



مراحل دقیقاً با مثال ۲ یکسان است، فقط محدوده انتگرال

از $-\infty$ تا $+\infty$ است.

$$B_P = \frac{\mu_0 i}{4\pi h} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} \right)_{-\infty}^{\infty} \rightarrow B_P = \frac{\mu_0 i}{2\pi h}$$

در وینو.

✓ مثال ۵- از یک سیم به شکل ربع دایره به شعاع R، جریان i مطابق شکل می‌گذرد. میدان مغناطیسی در مرکز ربع دایره چیست؟



$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 i dl}{4\pi R^2}$$

نیاز به تجزیه کردن ندارد.

$$B_P = \int dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi R^2} \int dl = \frac{\mu_0 i l}{4\pi R^2}, \quad \text{طول } l = \frac{\pi}{2} R$$

$$\rightarrow B_P = \frac{\mu_0 i}{8R}$$

در وینو.

مثال ۶. از یک سیم به شکل کمان دایره به شعاع R ، مقابل زاویه مرکزی β ، جریان i مطابق شکل می‌گذرد. میدان



$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left(\frac{dl \sin \theta}{r^2} \right)$$

$$\rightarrow dB = \frac{\mu_0 i dl}{4\pi R^2}$$

مغناطیسی را در مرکز کمان حساب کنید.

$$B_P = \int dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi R^2} \int dl = \frac{\mu_0 i l}{4\pi R^2} \quad , \quad l = R\beta \rightarrow B_P = \frac{\mu_0 i \beta}{4\pi R}$$

$$\text{حالت‌های خاص:} \quad \beta = \frac{\pi}{2} \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{8R} \quad \text{سیم به شکل ربع دایره}$$

$$\beta = \pi \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{4R} \quad \text{سیم به شکل نیم دایره}$$

$$\beta = \frac{3\pi}{2} \rightarrow B = \frac{3\mu_0 i}{8R} \quad \text{سیم به شکل سه ربع دایره}$$

$$\beta = 2\pi \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2R} \quad \text{حلقه جریان} \rightarrow \text{سیم به شکل دایره}$$

مثال ۷. از یک سیم مطابق شکل، جریان i می‌گذرد. میدان مغناطیسی در نقطه P حیدر است.



شکل دی ترکیبی را به اجزای ساده تقسیم کرده و از اصل برهم نهی استفاده می‌کنیم.

$$\vec{B}_P = \sum \vec{B}_i = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 i}{4a} \quad (\text{بردینسو}) \quad \text{میدان نیم دایره به شعاع } a$$

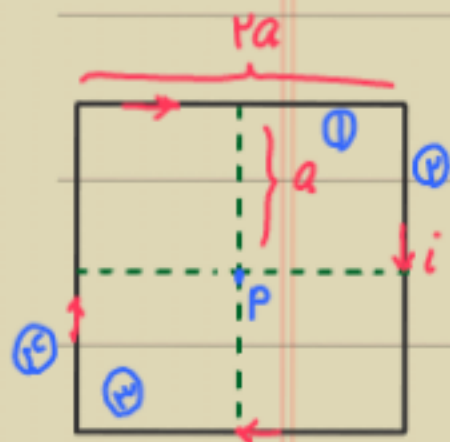
$$B_3 = B_4 = 0 \quad \text{سیم در امتداد خود}$$

میدان ایجاد نمی‌کند.

$$B_2 = \frac{\mu_0 i}{4b} \quad (\text{در دینسو}) \quad \text{میدان نیم دایره به شعاع } b$$

$$B_P = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \quad \text{اثر بردینسو + فرنیسور}$$

مثال ۸. از یک حلقه به شکل مربع به ضلع $2a$ جریان i می‌گذرد. میدان مغناطیسی در مرکز مربع حیدر است؟



نقطه P روی عمود وسط اضلاع مربع و به فاصله a از هر سیم قرار دارد. با استفاده از مثال ۳:

$$B = \frac{\mu_0 i l}{4\pi h \sqrt{a^2 + h^2}} \quad \frac{l=2a}{h=a} \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 i (2a)}{4\pi a \sqrt{a^2 + a^2}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi a \sqrt{2}} = B_2 = B_3 = B_4$$

$$B_P = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 \rightarrow B = 4B_1 = \frac{2\mu_0 i}{\pi a \sqrt{2}} \quad \text{در دینسو}$$



$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left(\frac{dl \sin \theta}{r^2} \right) = \frac{\mu_0 i dl}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\sin \gamma = \frac{x}{r}, \quad \cos \gamma = \frac{R}{r}$$

به دلیل تقارن موله‌های عمودی میدان با هم خنثی می‌شوند $B_{\perp} = 0$ $\rightarrow$ $dB_{\perp} = dB \sin \gamma$

$$dB_{\parallel} = dB \cos \gamma = \frac{\mu_0 i dl}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{(x^2 + R^2)}} = \frac{\mu_0 i R dl}{4\pi (x^2 + R^2)^{5/2}}$$

$$B_{\parallel} = \int dB_{\parallel} = \frac{\mu_0 i R}{4\pi (x^2 + R^2)^{5/2}} \int dl = \frac{\mu_0 i R}{4\pi (x^2 + R^2)^{5/2}} (2\pi R) \rightarrow B = \frac{\mu_0 i R^2}{2 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

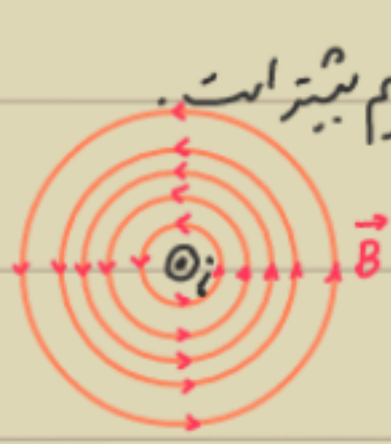
حالت‌های خاص: در مرکز حلقه $x=0$ $\rightarrow$ $B = \frac{\mu_0 i}{2R}$

برای نقاط دور $x \gg R$ $\rightarrow$ $B = \frac{\mu_0 i R^2}{2 x^3}$

بر حسب شدت و جهت‌ی مغناطیسی $\mu = n i A = (1)(i)(\pi R^2) = \pi R^2 i$

$$B = \frac{\mu_0 i \pi R^2}{2\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

قانون آمپر: برای یک سیم مستقیم نامتناهی حامل جریان i ، م‌دهه شده که خطوط میدان در اطراف سیم به شکل دایره‌ای متحدالمرکزند که سیم در مرکز قرار گرفته و تراکم خطوط نزدیک سیم بیشتر است.



اگر مقطع سیم را در نظر بگیریم:

میدان مغناطیسی بر فاصله و سیم عمود است.

اگر مسیر بسته‌ای اطراف سیم حامل جریان گرفته شود، همواره خواهیم داشت: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$

رابطه بالا به قانون آمپر معروف است که در آن: B میدان مغناطیسی، l الان طول از مسیر بسته.

μ ثابت نفوذپذیری خلاء، i_m جریان خالص داخل مسیر بسته است.

✓ به قانون گاوس در الکتریسیته، قانون آمپر هم در حالت کلی صادق است ولی برای استفاده در مایه میدان ماده سازی صورت

نمیگیرد و به همین علت محدودیت در کاربرد ایجاد می شود.

برای استفاده از قانون آمپر مراحل زیر انجام می شود:

انتخاب یک مسیر بسته مناسب (پریبند آمپری) که: ۱. از نقطه مورد نظر بگذرد ۲. زاویه میدان مسیر پریبند با میدان

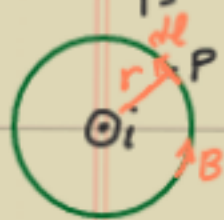
هم جا صفر باشد (یا در برخی نقاط زاویه صفر و در سایر نقاط زاویه 90°) ۳. مقدار میدان روی پریبند ثابت باشد.

این شرایط، دامنه حل مسائل را محدود می کند به: الف) جایی که خطوط میدان به صورت دایره باشند (سیم مستقیم بلند یا مقطع

دایره) که پریبند آمپری به شکل دایره به شعاع r است. ب) وقتی خطوط میدان موازی (میدان یکپارچه) است پریبند

آمپری به شکل مستطیل انتخاب می شود.

مثال ۱- میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم نازک مستقیم و نامتناهی با جریانی i را در نقطه ای به فاصله r از سیم حساب کنید.



پریبند آمپری به شکل دایره به شعاع r گرفته و آنرا درست میدان دوری کنیم.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{in} \rightarrow \oint B dl \cos 0 = \oint B dl = B l = B 2\pi r = \mu_0 i \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

مثال ۱۱- از یک کابل مستقیم و طولی با شعاع R جریانی i با چگالی جریانی ثابت می گذرد. میدان مغناطیسی را داخل و خارج



کابل می باشد کنید. (جریان یکنواخت).

$$r < R \rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{in} \rightarrow B 2\pi r = \mu_0 i_{in}$$

جریان کل از سطح مقطع: چون جریانی یکنواخت است:

$$\begin{array}{ccc} \text{از سطح مقطع} & & \text{جریان کل} \\ \pi R^2 & & i \\ \pi r^2 & \rightarrow & i_{in} \\ \text{از سطح آمپری} & & \end{array} \quad i_{in} = i \frac{r^2}{R^2}$$

$$B 2\pi r = \mu_0 i \frac{r^2}{R^2} \rightarrow B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{in} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 i \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

مثال ۱۲- از یک کابل مستقیم حامل جریان با شعاع R، جریانی با چگالی

ی گذرد. میدان مغناطیسی را داخل و خارج کابل بدست آورید.



$$r < R: \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{in} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 i_{in}$$

$$i_{in} = \int \vec{J} \cdot d\vec{s} = \int_0^r A r' \cdot 2\pi r' dr' = 2\pi A \left(\frac{r^3}{3}\right)_0^r = \frac{2\pi A r^3}{3}$$

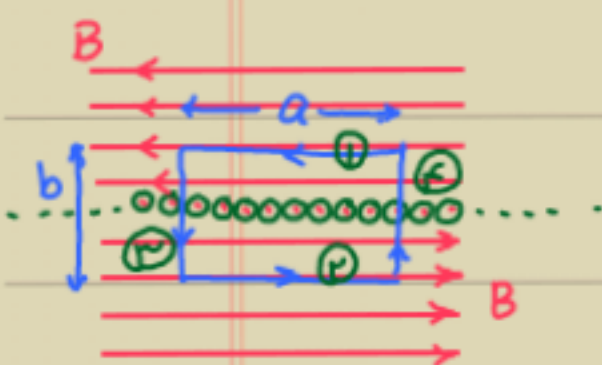
$$\left. \begin{aligned} & B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{2\pi A r^3}{3} \rightarrow B = \frac{\mu_0 A r^2}{3} \end{aligned} \right\}$$

$$r > R: \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{in} \rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 i_{in}$$

$$i_{in} = \int \vec{J} \cdot d\vec{s} = \int_0^R A r' \cdot 2\pi r' dr' + \int_R^r 0 = 2\pi A \left(\frac{r'^3}{3}\right)_0^R = \frac{2\pi A R^3}{3}$$

$$\left. \begin{aligned} & B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{2\pi A R^3}{3} \rightarrow B = \frac{\mu_0 A R^3}{3r} \end{aligned} \right\}$$

۱۳- تعدادی سیم نازک مستقیم حامل جریان همسوی مساری نه کنار هم در یک صفحه قرار گرفته اند (تعداد سیم در واحد طول N).



میدان مغناطیسی را در نقاط اطراف این مجموعه حساب کنید.

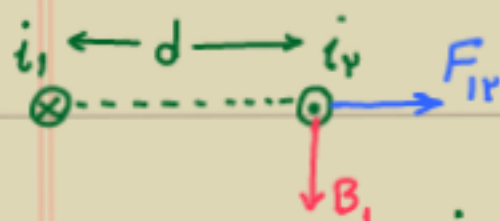
باتوجه به شکل خطوط میدان، پیرامون آمپری به شکل مستطیل در نظر گرفته شده است.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{in} \rightarrow \int_1 B dl \cos 0 + \int_2 B dl \cos 0 + \int_3 B dl \cos 90 + \int_4 B dl \cos 90 = \mu_0 i_{in}$$

در واحد طول	تعداد سیم	از هر سیم	جریان
1	n	1	i
در طول پیرامند a	x	از na	$i_{in} \rightarrow i_{in} = n a i$

$$\rightarrow B a + B a = \mu_0 n a i \rightarrow B = \frac{\mu_0 n i}{2}$$

۱۴- از دو سیم موازی جریان دای نه و نه خلاف جهت هم می گذرد. فاصله میان دو سیم برابر d است. نیروی که یک سیم بر

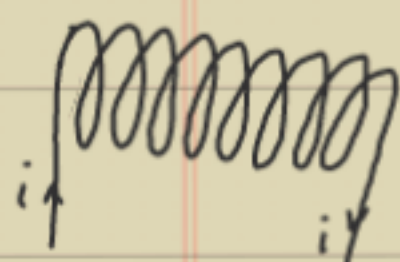


طول d از سیم دیگر وارد می کند، چقدر است؟

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi d} \rightarrow F_{12} = i_2 l B_1 \sin 90 \Rightarrow F_{12} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 l}{2\pi d}$$

دو سیم با جریان دای مخالف، یکدیگر را دافع می کنند.

۱۵- سیم نازکی را به شکل سیموله (منه) درآورده و از آن جریان i می‌گذرد. اگر تعداد دورهای سیموله در واحد طول n باشد،



میدان مغناطیسی داخل و خارج سیموله چیست؟

میدان ناشی از متقاطع سیم d در بالا و پایین میدان d

با جهت مخالف ایجاد می‌کند. خارج سیموله میدان صفر است.

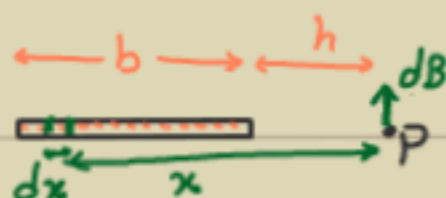
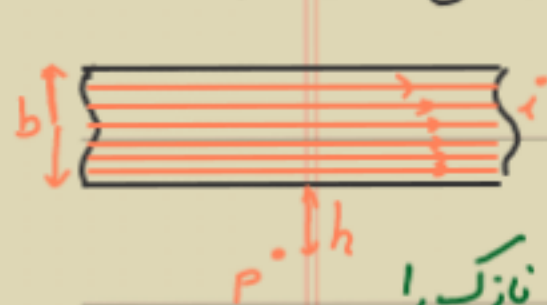
پروبند آیری به شکل مستطیل به طول a و عرض b (مانند شکل ۱۳) در نظر گرفته شود.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{in}$$

$$\int_1 B dl \cos 0 + \int_2 B dl \cos 90 + \int_3 0 + \int_4 B dl \cos 90 = Ba = \mu_0 i_{in} \rightarrow Ba = \mu_0 n a i$$

$$i_{in} = \text{تعداد سیم} \times i = n a i \rightarrow B = \mu_0 n i$$

شکل ۱۶- از یک نوار نازک و طولی به پهنای b ، جریان یکنواخت i می‌گذرد. میدان مغناطیسی در نقطه ای واقع در صفحه نوار و به فاصله h



از یک طرف نوار چیست؟

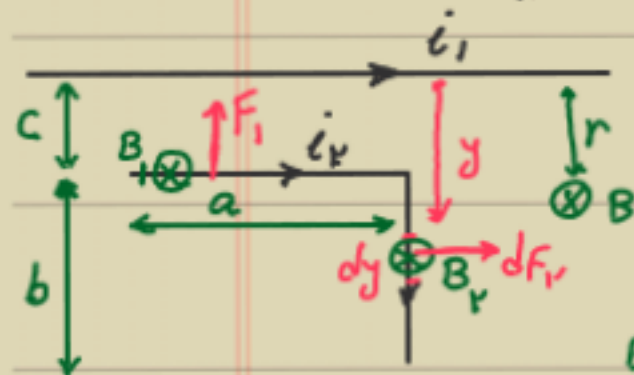
نوار را به همان دی نازک (سیم) به پهنای dx تقسیم کرده، از قانون آیر، میدان سیم نازک را

استفاده می‌کنیم.

$$dB = \frac{\mu_0 di}{2\pi x}, \quad di = \frac{i}{b} dx \rightarrow dB = \frac{\mu_0 i dx}{2\pi b x}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 i}{2\pi b} \int_h^{b+h} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 i}{2\pi b} \left[\ln x \right]_h^{b+h} \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi b} \ln\left(\frac{b+h}{h}\right)$$

شکل ۱۷- از یک سیم مستقیم طولی جریان i می‌گذرد. سیمی با جریان i_r مطابق شکل، کنار سیم ① قرار گرفته. نیروی وارد بر سیم ②



از طرف سیم ① چیست؟ میدان سیم ① در نقطه ای به فاصله r از سیم $B = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r}$

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \rightarrow F_1 = i_2 a B_1 \sin 90 = \frac{\mu_0 i_1 i_2 a}{2\pi r}$$

در نقطه ای به فاصله y از سیم ① $B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi y}$ $dF_1 = i_2 dy B_1 \sin 90 = \frac{\mu_0 i_1 i_2 dy}{2\pi y}$

$$F_1 = \int_c^{b+c} dF_1 = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi} \int_c^{b+c} \frac{dy}{y} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi} \left(\ln y \right)_c^{b+c} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi} \ln\left(\frac{b+c}{c}\right)$$

$$\vec{F} = F_1 \hat{i} + F_2 \hat{j}$$